NEW PRODUCT

DDTC (R2-ONLY SERIES) CA

NPN PRE-BIASED SMALL SIGNAL SOT-23 SURFACE MOUNT TRANSISTOR

Please click here to visit our online spice models database.

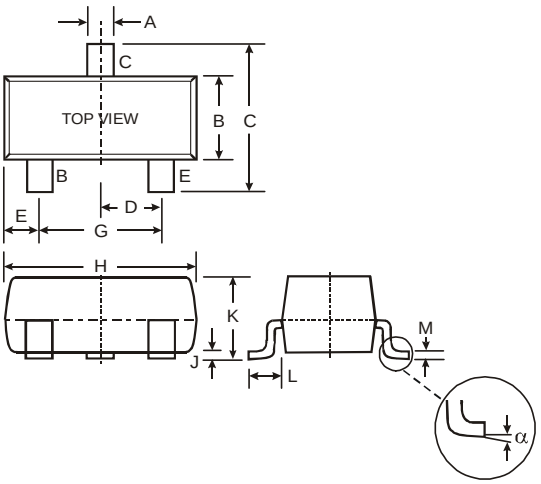
Features

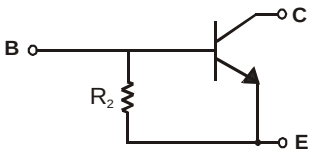
- Epitaxial Planar Die Construction
- Complementary PNP Types Available (DDTA)
- Built-In Biasing Resistor, R2 only
- **Lead, Halogen and Antimony Free, RoHS Compliant "Green" Device (Notes 2 and 3)**

Mechanical Data

- Case: SOT-23
- Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminal Connections: See Diagram
- Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Lead Free Plating (Matte Tin Finish annealed over Alloy 42 leadframe).
- Marking: Date Code and Marking Code (See Table Below & Page 4)
- Ordering Information: See Page 4
- Weight: 0.008 grams (approximate)

P/N	R2 (NOM)	MARKING
DDTC114GCA	10KΩ	N26
DDTC124GCA	22KΩ	N27
DDTC144GCA	47KΩ	N28
DDTC115GCA	100KΩ	N29





SCHEMATIC DIAGRAM

SOT-23		
Dim	**Min**	**Max**
A	0.37	0.51
B	1.20	1.40
C	2.30	2.50
D	0.89	1.03
E	0.45	0.60
G	1.78	2.05
H	2.80	3.00
J	0.013	0.10
K	0.903	1.10
L	0.45	0.61
M	0.085	0.180
α	0°	8°
All Dimensions in mm		

Maximum Ratings @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	50	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	50	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5	V
Collector Current	I_C (Max)	100	mA
Power Dissipation	P_D	200	mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (Note 1)	$R_{\theta JA}$	625	°C/W
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-55 to +150	°C

Notes:
1. Mounted on FR4 PC Board with recommended pad layout as shown on Diodes Inc., suggested pad layout document AP02001, which can be found on our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf
2. No purposefully added lead. Halogen and Antimony Free.
3. Product manufactured with Data Code V9 (week 33, 2008) and newer are built with Green Molding Compound. Product manufactured prior to Date Code V9 are built with Non-Green Molding Compound and may contain Halogens or Sb_2O_3 Fire Retardants.

NEW PRODUCT

Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Characteristic		Symbol	Min	Typ	Max	Unit	Test Condition
Collector-Base Breakdown Voltage		BV_{CBO}	50	—	—	V	I_C = 50μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage		BV_{CEO}	50	—	—	V	I_C = 1mA
Emitter-Base Breakdown Voltage		BV_{EBO}	5	—	—	V	I_E = 720μA, DDTC114GCA I_E = 330μA, DDTC124GCA I_E = 160μA, DDTC144GCA I_E = 72μA, DDTC115GCA
Collector Cutoff Current		I_{CBO}	—	—	0.5	μA	V_{CB} = 50V
Emitter Cutoff Current	DDTC114GCA DDTC124GCA DDTC144GCA DDTC115GCA	I_{EBO}	300 140 65 30	—	580 260 130 58	μA	V_{EB} = 4V
Collector-Emitter Saturation Voltage		$V_{CE(sat)}$	—	—	0.3	V	I_C = 10mA, I_B = 0.5mA
DC Current Transfer Ratio	DDTC114GCA DDTC124GCA DDTC144GCA DDTC115GCA	h_{FE}	30 56 68 82	—	—	—	I_C = 5mA, V_{CE} = 5V
Bleeder Resistor (R_2) Tolerance		ΔR_2	-30	—	+30	%	—
Gain-Bandwidth Product*		f_T	—	250	—	MHz	V_{CE} = 10V, I_E = -5mA, f = 100MHz

* Transistor - For Reference Only

NEW PRODUCT

Typical Curves – DDTC114GCA

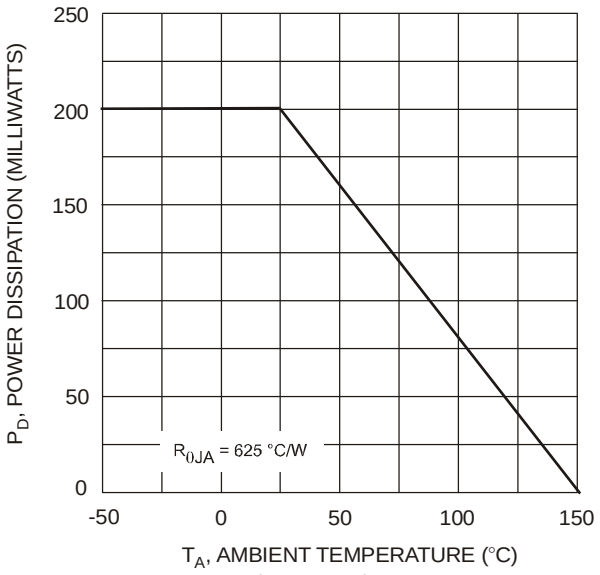


Fig. 1 Derating Curve

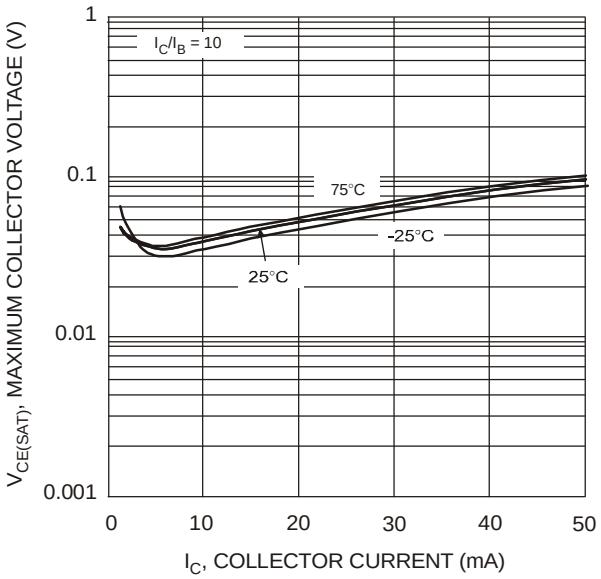


Fig. 2 $V_{CE(SAT)}$ vs. I_C

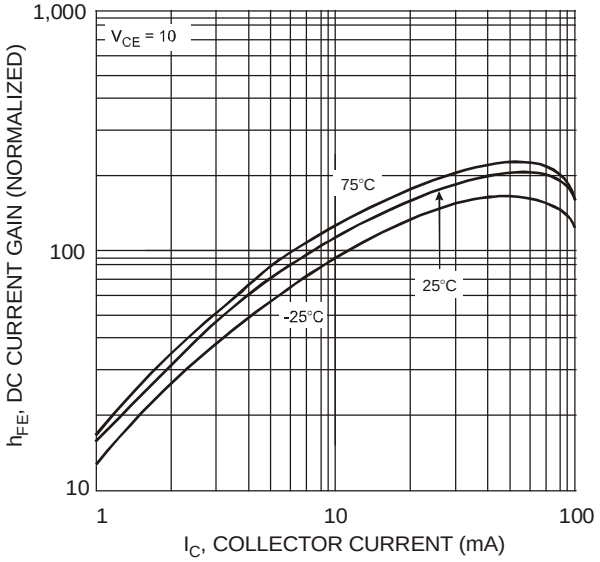


Fig. 3 DC Current Gain

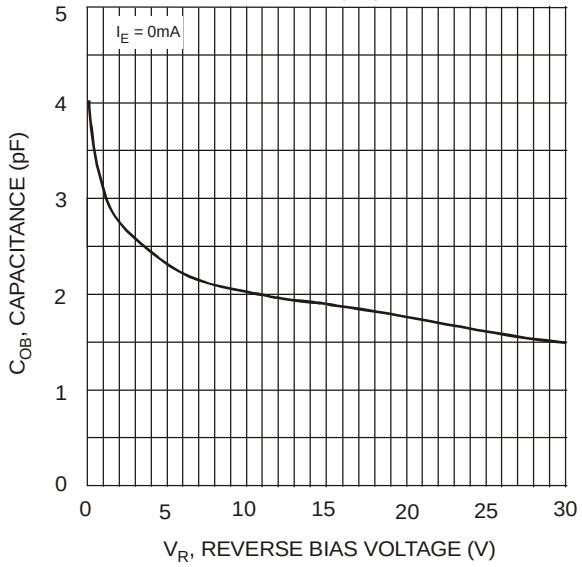


Fig. 4 Output Capacitance

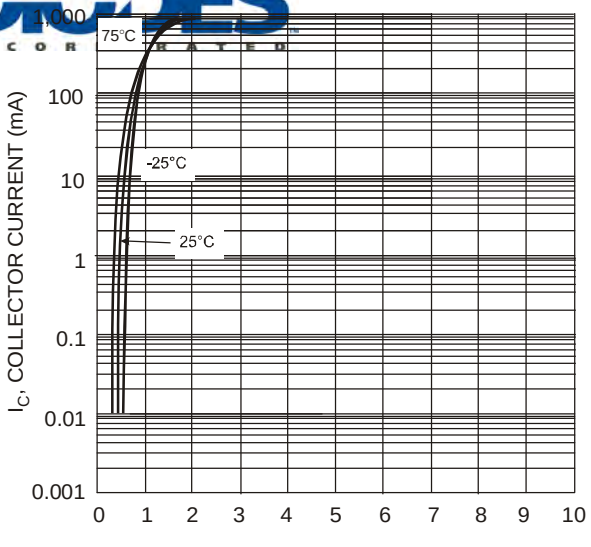


Fig. 5 Collector Current vs. Input Voltage

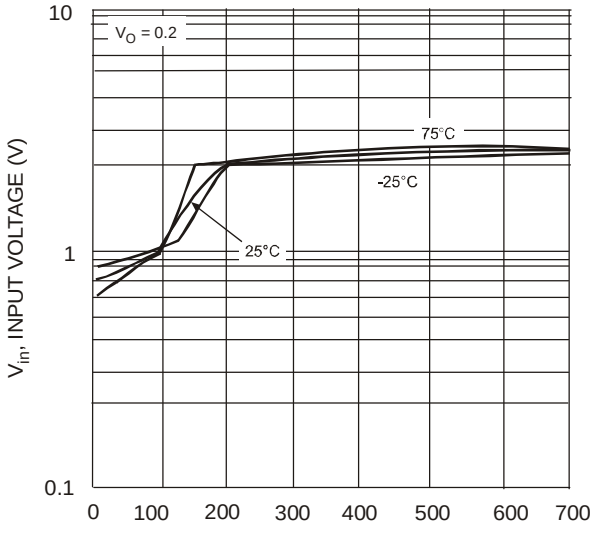


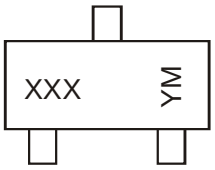
Fig. 6 Input Voltage vs. Collector Current

Ordering Information (Note 4)

Device	Packaging	Shipping
DDTC114GCA-7-F	SOT-23	3000/Tape & Reel
DDTC124GCA-7-F	SOT-23	3000/Tape & Reel
DDTC144GCA-7-F	SOT-23	3000/Tape & Reel
DDTC115GCA-7-F	SOT-23	3000/Tape & Reel

Notes: 4. For packaging details, go to our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02007.pdf.

Marking Information



XXX = Product Type Marking Code, See Table on Page 1
YM = Date Code Marking
Y = Year ex: T = 2006
M = Month ex: 9 = September

Date Code Key

Year	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Code	T	U	V	W	X	Y	Z

Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	O	N	D

NEW PRODUCT

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9